

**КТ6114**  
кремниевый биполярный  
эпитаксиально-планарный  
п-р-п транзистор

### Назначение

Транзистор п-р-п кремниевый эпитаксиально-планарный. Предназначен для использования в высокочастотных устройствах, в узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры, изготавливаемой для народного хозяйства

### Зарубежные прототипы

- прототипы SS8050B, C, B

### Номер технических условий

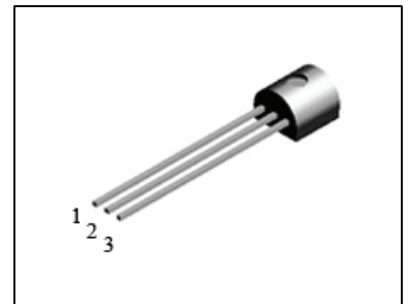
- АДБК.432140.422 ТУ

### Особенности

- Диапазон рабочих температур от - 45 до + 100°С

### Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)



### Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Коллектор
№2	База
№3	Эмиттер

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ6114 при  $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$** 

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор- эмиттер	Укэо гр.	В	Иэ=10мА, Иб=0	15	
Обратный ток коллектора	Ikбо	нА	Укб=35В, Иэ=0		25
Обратный ток эмиттера	Иэбо	мкА	Уэб=5В, Ik=0		10
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$		Укб=35В, Ik=100мА	45	630
Емкость коллекторного перехода	Ск	Пф	Укб=10В, Иэ=0, f=1МГц		1,7
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	Укэ(нас)	В	Ik=10мА, Иб=1мА		0,5
Граничная частота коэф. передачи тока	fгр.	МГц	Укэ=10В, Иэ=50мА	100	

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ6114**

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Укб max	В	40
Напряжение коллектор-эмиттер	Укэ max	В	25
Напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	6
Постоянный ток коллектора	Ik max	мА	50
Рассеиваемая мощность коллектора КТ6114А, Б, В	Рк max	Вт	1,0
КТ6114Г, Д, Е			0,7
Температура перехода	Tj	°С	150
Тепловое сопротивление переход-среда КТ6114А, Б, В	Rt пер-ср	°С/Вт	125
КТ6114Г, Д, Е			175

**Таблица 3. Классификация коэффициента усиления h21E**

Группа	КТ6114А	КТ6114Б	КТ6114В	КТ6114Г	КТ6114Д	КТ6114Е
Значение	28-45	39-60	54-80	72-108	97-146	132-198